

半導体を中心とする電子デバイスのプロセス技術において、材料表面を清浄化・改質する技術はデバイス界面の信頼性に対して極めて重要である。また、ウェットプロセスを用いた新規なエッチングや薄膜を形成する技術は、デバイスの微細化・三次元化のひとつのテクノロジードライバである。本研究会は界面ナノ現象を明らかにすることでウェットプロセスに関する学問を構築し、次世代へと教育できる環境を整えている。同時に本研究会成果物の実行者である若手の主体性が極めて重要であることから、若手の主体性強化を目的としたポスター発表展を2015年より企画している。若手技術者とベテラン技術者とのFace to Faceの活発な議論を期待して、下記の要項で第9回ポスター展を開催する。あわせて育成ワーキンググループの新たな活動としてチュートリアルを開催する。

## 若手のポスター発表展 ーベテランとの議論に打ち勝て！ー

- 主催：公益社団法人 応用物理学会 界面ナノ電子化学研究会
- 日時：2025年6月20日(金) 10：25～17：45
- 会場：栗田工業 Kurita Innovation Hub(KIH) (東京都昭島市代官山)  
現地発表のみ
- 開催概要： 育成ワーキンググループ「枚葉式ウェットプロセスのための流体力学」  
真田俊之 教授 (静岡大学学術院 工学専攻)  
第9回ポスター発表展 (発表件数：28件)

|         | 開催時間        | 参加費         | 定員 |
|---------|-------------|-------------|----|
| 育成WG    | 10：25～12：30 | 2000円(学生無料) | 80 |
| ポスター発表展 | 13：15～17：45 | 2000円(学生無料) | 80 |

- 申込方法：  
参加申込先URLもしくはQRコードより、申し込みをお願いします。  
[https://eventpay.jp/event\\_info/?shop\\_code=0672069005389223&EventCode=7840390415](https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=0672069005389223&EventCode=7840390415)  
※参加費用のお支払いは、クレジットカードによる事前オンライン決済のみとなります。  
(決済には株式会社メタックスペイメントの「イベントペイ」を使用します)
- 申込締切：2025年5月30日(金) 17時 ※定員に限りがあるので早めに参加お申込みください
- ポスター発表展終了後、会場にて第38回カサロス(懇親会)を開催します。(別々に申し込みが必要です。)
- 世話役：  
オルガノ 蔦野恭平 tsutano-k@organo.co.jp  
東京エレクトロン 山中励二郎 reijiro.yamanaka@tel.com  
日本インテグリス 永渕琢也 takuya.nagafuchi@entegris.com

参加申込先



## ◆育成ワーキンググループ プログラム

| 時刻          | 内容                                             |
|-------------|------------------------------------------------|
| 10:00～10:25 | 育成ワーキンググループ受付開始                                |
| 10:25～10:30 | 開会挨拶：有馬副委員長                                    |
| 10:30～12:30 | 「枚葉式ウェットプロセスのための流体力学」<br>真田俊之 教授（静岡大学学術院 工学専攻） |
| 12:30～13:15 | 休憩 ※昼食は各自準備をお願いします。食事場所は同会場になります               |

## ◆ポスター発表展 プログラム

| 時刻          | 内容                        |
|-------------|---------------------------|
| 12:30～13:15 | ポスター発表展受付                 |
| 13:15～13:30 | 開会挨拶：岩元委員長、KIH施設紹介：栗田工業様  |
| 13:30～14:40 | ライトニングトーク                 |
| 14:40～14:50 | 休憩（レイアウト変更）               |
| 14:50～15:40 | ポスターセッション（奇数番号）：14件       |
| 15:40～15:50 | 休憩（レイアウト変更）               |
| 15:50～16:40 | ポスターセッション（偶数番号）：14件       |
| 16:40～17:25 | KIH 施設案内                  |
| 17:25～17:35 | INE活動報告：吉水副委員長            |
| 17:35～17:45 | 表彰式&閉会挨拶：有馬副委員長<br>集合写真撮影 |
| 17:45～19:15 | 第38回カサロス（懇親会）             |

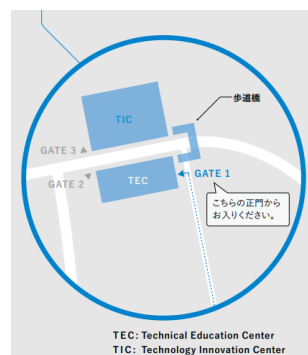
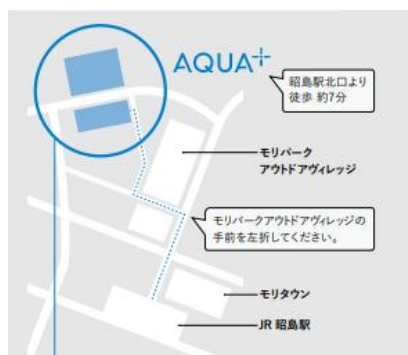
（最終退出 20：00）

### 会場案内

東京都昭島市代官山1-4-1

JR青梅線 昭島駅北口より徒歩約7分

駐車場・駐輪場はありません。  
公共交通機関をご利用ください。



# 第9回ポスター発表展

## タイトル

## 発表者

## 所属

|    |                                                                                                            |         |                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|
| 1  | 純水二流体スプレー時のSiO <sub>2</sub> ウェハの表面ポテンシャル                                                                   | 伊藤 康生   | 愛知工業大学                     |
| 2  | 二流体スプレー時の純水液滴の帯電制御                                                                                         | 渡部 一哲   | 愛知工業大学                     |
| 3  | LA-GED-MSAG-ICPMSを用いたウェーハベベルの金属不純物の局所分析                                                                    | 西 晃良    | ローツェイアス株式会社                |
| 4  | 先端デバイス向け超純水用イオン交換樹脂の新規評価技術                                                                                 | 相原 健司   | オルガノ株式会社                   |
| 5  | 原子スケールシミュレーションによるCMPメカニズムの解析                                                                               | 増谷 浩一   | 株式会社 荏原製作所                 |
| 6  | Cu-CMP後洗浄におけるブラシセルフクリーニング性能の影響因子の検討                                                                        | 漆原 夏子   | 株式会社 荏原製作所                 |
| 7  | CMP後洗浄におけるセリア残留物の形態分析                                                                                      | 西 智也    | 株式会社 荏原製作所                 |
| 8  | DryとWetを組み合わせた精密エッチング                                                                                      | 住野 稜太   | 株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ |
| 9  | 先端3D半導体パッケージングのための持続可能な洗浄ソリューション：機能性水によるハイブリッド接合の最適化                                                       | 岡崎 有祐   | 栗田工業株式会社                   |
| 10 | H <sub>2</sub> プラズマを用いたITO高温加工プロセスの表面反応メカニズム考察                                                             | 鈴木 涼平   | ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社     |
| 11 | スチーム混合SPMによるハイドロズインプラントレジスト剥離                                                                              | 水口 将輝   | 東京エレクトロン九州株式会社             |
| 12 | ウェット処理後のH終端化Si(111)表面の局所構造観察—非接触AFMとSTMで得られる画像の比較と考察—                                                      | 高橋 亜弓   | 大阪大学                       |
| 13 | Removal of Metals from Strong and Weak Acids using Membrane based solutions to Reduce On-wafer Defectivity | 守田 峻海   | 日本インテグリス合同会社               |
| 14 | 高濃度オゾン水によるレジスト剥離 (Resist stripping with High Concentration O <sub>3</sub> -Water)                          | 山田 賢吾   | 野村マイクロ・サイエンス株式会社           |
| 15 | 複合分析を用いたPDAによるSiO <sub>2</sub> /SiN <sub>x</sub> /Si積層膜への影響解析                                              | 五十嵐 陽彦  | 株式会社東レリサーチセンター             |
| 16 | 東レエンジニアリングの水質分析計                                                                                           | 寺田 豊治   | 東レエンジニアリング株式会社             |
| 17 | 重水を用いた狭所エッチングレート低下要因の検証                                                                                    | 小幡 匠    | 株式会社SCREENホールディングス         |
| 18 | 半導体基板上に形成した極薄酸化膜における物理定数の新解析法—X                                                                            | 高野 宏樹   | 大阪大学                       |
| 19 | 第一原理計算を用いたSi(111)表面上へのAgの吸着構造解析—制御性に優れたAgナノワイヤの形成に向けて—                                                     | 京田 晴菜   | 大阪大学                       |
| 20 | ウェーハ両面を同時に処理できるベベルフリーウェーハ保持技術を備えた物理洗浄装置                                                                    | 三牧 勲大   | 東京エレクトロン九州株式会社             |
| 21 | 狭ピッチハイブリッド接合実現に向けた低ダメージCu洗浄プロセス                                                                            | 神谷 佑哲   | 横浜国立大学                     |
| 22 | 二流体ジェットによって形成された液膜厚さ分布におけるノズル位置の影響                                                                         | 池ヶ谷 充貴也 | 静岡大学                       |
| 23 | PVAブラシの変形および変形に誘起された液体挙動の可視化                                                                               | 美和 誠人   | 静岡大学                       |
| 24 | 多目的ベイズ最適化を用いた3D NAND フラッシュメモリのためのWetエッチング装置設計最適化                                                           | 森 夕海    | キオクシア株式会社                  |
| 25 | Wafer接合における接合膜種と接合進展挙動の考察                                                                                  | 小池 美夏   | ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社     |
| 26 | アルカリ溶液種がシリコン結晶異方性ウェットエッチング特性に与える影響                                                                         | 平野 智暉   | ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社     |
| 27 | 枚葉式フッ硝酸Siエッチングにおけるドーパント濃度依存性解析                                                                             | 西尾 賢哉   | ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社     |
| 28 | 半導体ウェーハブラシ洗浄における微粒子除去過程に関する基礎研究                                                                            | 高田 康平   | 群馬大学                       |



## カサロス（懇親会）の詳細ご案内

- 主催：応用物理学会 界面ナノ電子化学研究会
- 日時：2025年6月20日(金) 17:45~19:15
- 参加費：6,000円（学生無料）
- 申込方法：参加申込先URLもしくはQRコードより、申し込みをお願いします。

[https://eventpay.jp/event\\_info/?shop\\_code=0672069005389223&EventCode=3738223373](https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=0672069005389223&EventCode=3738223373)

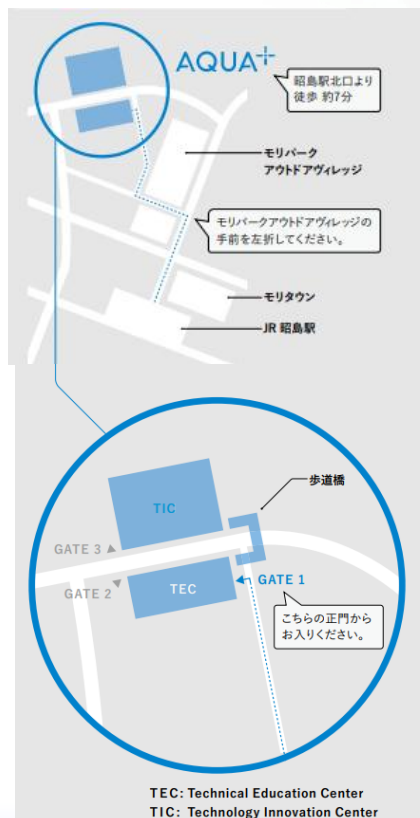
※参加費用のお支払いは、クレジットカードによる事前オンライン決済のみとなります。  
（決済には株式会社メタップスペイメントの「イベントペイ」を使用します）

- 申込締切：2025年5月30日(金) 17時
- 定員：80名 ※定員に限りがあるので早めに参加お申込みください。
- 会場：栗田工業 Kurita Innovation Hub(KIH)(ポスター展と同じ会場)

### 参加申込先



### 会場案内



東京都昭島市代官山1-4-1

JR青梅線 昭島駅北口より徒歩約7分



駐車場・駐輪場はありません。  
公共交通機関をご利用ください。